

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Dispositivi transistor avanzati Formule

[Calcolatrici!](#)[Esempi!](#)[Conversioni!](#)

Segnalibro [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

La più ampia copertura di calcolatrici e in crescita - **30.000+ calcolatrici!**

Calcola con un'unità diversa per ogni variabile - **Nella conversione di unità costruita!**

La più ampia raccolta di misure e unità - **250+ misurazioni!**

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)



© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!



## Lista di 20 Dispositivi transistor avanzati Formule

### Dispositivi transistor avanzati ↗

#### FET ↗

##### 1) Capacità della sorgente di gate del FET ↗

**fx**  $C_{gs(fet)} = \frac{T_{gs-off(fet)}}{\left(1 - \left(\frac{V_{ds(fet)}}{\Psi_0(fet)}\right)\right)^{\frac{1}{3}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $6.805694F = \frac{2.234s}{\left(1 - \left(\frac{4.8V}{4.976V}\right)\right)^{\frac{1}{3}}}$

##### 2) Capacità di drenaggio del gate del FET ↗

**fx**  $C_{gd(fet)} = \frac{T_{gd-off(fet)}}{\left(1 - \frac{V_{gd(fet)}}{\Psi_0(fet)}\right)^{\frac{1}{3}}}$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $6.475557F = \frac{6.47s}{\left(1 - \frac{0.0128V}{4.976V}\right)^{\frac{1}{3}}}$

##### 3) Corrente di drenaggio del FET ↗

**fx**  $I_d(fet) = I_{dss(fet)} \cdot \left(1 - \frac{V_{ds(fet)}}{V_{cut-off(fet)}}\right)^2$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.301384mA = 0.69mA \cdot \left(1 - \frac{4.8V}{2.89V}\right)^2$

##### 4) Corrente di drenaggio della regione ohmica del FET ↗

**fx**  $I_d(fet) = G_{o(fet)} \cdot \left(V_{ds(fet)} + \frac{3}{2} \cdot \frac{\left(\Psi_0(fet) + V_{ds(fet)} - V_{ds(fet)}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\Psi_0(fet) + V_{ds(fet)}\right)^{\frac{3}{2}}}{\left(\Psi_0(fet) + V_{off(fet)}\right)^{\frac{1}{2}}}\right)$

[Apri Calcolatrice ↗](#)

**ex**  $0.305501mA = 0.24mS \cdot \left(4.8V + \frac{3}{2} \cdot \frac{(4.976V + 4.8V - 4.8V)^{\frac{3}{2}} - (4.976V + 4.8V)^{\frac{3}{2}}}{(4.976V + 63.56V)^{\frac{1}{2}}}\right)$



5) Guadagno di tensione del FET 

$$\text{fx } A_{v(\text{fet})} = -G_m(\text{fet}) \cdot R_d(\text{fet})$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } -0.0064V = -0.02\text{mS} \cdot 0.32\text{k}\Omega$$

6) Ridurre la tensione del FET 

$$\text{fx } V_{\text{off}(\text{fet})} = V_{\text{ds-off}(\text{fet})} - V_{\text{ds}(\text{fet})}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(3e2231b1ad3ca8da8658228c00dd08e0\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 63.36V = 68.16V - 4.8V$$

7) Scarica la tensione della sorgente del FET 

$$\text{fx } V_{\text{ds}(\text{fet})} = V_{\text{dd}(\text{fet})} - I_{\text{d}(\text{fet})} \cdot (R_{\text{d}(\text{fet})} + R_{\text{s}(\text{fet})})$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(0d5ec72f61334709c3fc9450209b754f\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 4.8407V = 5V - 0.3\text{mA} \cdot (0.32\text{k}\Omega + 0.211\text{k}\Omega)$$

8) Transconduttanza del FET 

$$\text{fx } G_m(\text{fet}) = \frac{2 \cdot I_{\text{dss}(\text{fet})}}{V_{\text{off}(\text{fet})}} \cdot \left(1 - \frac{V_{\text{ds}(\text{fet})}}{V_{\text{off}(\text{fet})}}\right)$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(b64b40baaee5acddc1eab8538ba84754\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 0.020072\text{mS} = \frac{2 \cdot 0.69\text{mA}}{63.56\text{V}} \cdot \left(1 - \frac{4.8\text{V}}{63.56\text{V}}\right)$$

IGBT 9) Caduta di tensione nell'IGBT in stato ON 

$$\text{fx } V_{\text{ON}(\text{igbt})} = i_{\text{f}(\text{igbt})} \cdot R_{\text{ch}(\text{igbt})} + i_{\text{f}(\text{igbt})} \cdot R_{\text{d}(\text{igbt})} + V_{\text{j1}(\text{igbt})}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(c15650232aa6660c9deb34f3b82dcb72\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 20.2533\text{V} = 1.69\text{mA} \cdot 10.59\text{k}\Omega + 1.69\text{mA} \cdot 0.98\text{k}\Omega + 0.7\text{V}$$

10) Capacità di ingresso dell'IGBT 

$$\text{fx } C_{\text{in}(\text{igbt})} = C_{(\text{g-e})(\text{igbt})} + C_{(\text{g-c})(\text{igbt})}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(06b7456efb47d301bca6298603e7f4fc\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 5.76\text{F} = 0.21\text{F} + 5.55\text{F}$$

11) Corrente dell'emettitore dell'IGBT 

$$\text{fx } I_{\text{e}(\text{igbt})} = I_{\text{h}(\text{igbt})} + i_{\text{e}(\text{igbt})}$$

[Apri Calcolatrice !\[\]\(fed825e7856867ee486f6761f9a89d91\_img.jpg\)](#)

$$\text{ex } 12.523\text{mA} = 12.2\text{mA} + 0.323\text{mA}$$



## 12) Corrente di collettore continua nominale dell'IGBT ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$fx \quad i_{f(igbt)} = \frac{-V_{ce(igbt)} + \sqrt{(V_{ce(igbt)})^2 + 4 \cdot R_{ce(igbt)} \cdot \left( \frac{T_{jmax(igbt)} - T_{c(igbt)}}{R_{th(jc)}(igbt)} \right)}}{2 \cdot R_{ce(igbt)}}$$

$$ex \quad 1.691553mA = \frac{-21.56V + \sqrt{(21.56V)^2 + 4 \cdot 12.546k\Omega \cdot \left( \frac{283^{\circ}C - 250^{\circ}C}{0.456k\Omega} \right)}}{2 \cdot 12.546k\Omega}$$

## 13) Massima dissipazione di potenza negli IGBT ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$fx \quad P_{max(igbt)} = \frac{T_{jmax(igbt)}}{\theta_{j-c}(igbt)}$$

$$ex \quad 110.2597W = \frac{283^{\circ}C}{289^{\circ}}$$

## 14) Orario di spegnimento dell'IGBT ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$fx \quad T_{off(igbt)} = T_{dl(igbt)} + t_{f1(igbt)} + t_{f2(igbt)}$$

$$ex \quad 3.472s = 1.15s + 1.67s + 0.652s$$

## 15) Tensione di rottura della polarizzazione diretta dell'IGBT ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$fx \quad BV_{soa(igbt)} = \frac{5.34 \cdot 10^{13}}{(N_p(igbt))^{\frac{3}{4}}}$$

$$ex \quad 37.53628V = \frac{5.34 \cdot 10^{13}}{(16e15C)^{\frac{3}{4}}}$$

## 16) Tensione di saturazione dell'IGBT ↗

[Apri Calcolatrice ↗](#)

$$fx \quad V_{c-e(sat)(igbt)} = V_{B-E(pnp)(igbt)} + I_d(igbt) \cdot (R_s(igbt) + R_{ch(igbt)})$$

$$ex \quad 1222.25V = 2.15V + 105mA \cdot (1.03k\Omega + 10.59k\Omega)$$



**TRIAC****17) Corrente di carico media del TRIAC**

$$\text{fx } I_{\text{avg(triac)}} = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot I_{\text{rms(triac)}}}{\pi}$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 0.081028\text{mA} = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot 0.09\text{mA}}{\pi}$$

**18) Corrente di carico RMS del TRIAC**

$$\text{fx } I_{\text{rms(triac)}} = \frac{I_{\text{peak(triac)}}}{2}$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 0.09\text{mA} = \frac{0.18\text{mA}}{2}$$

**19) Dissipazione di potenza del TRIAC**

$$\text{fx } P_{\text{max(triac)}} = V_{\text{knee(triac)}} \cdot I_{\text{avg(triac)}} + R_s(\text{triac}) \cdot I_{\text{rms(triac)}}^2$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 0.294215\text{mW} = 3.63\text{V} \cdot 0.081028\text{mA} + 0.0103\text{k}\Omega \cdot (0.09\text{mA})^2$$

**20) Temperatura massima di giunzione del TRIAC**

$$\text{fx } T_{j\text{max(triac)}} = T_a(\text{triac}) + P_{(\text{triac})} \cdot R_{\text{th(j-a)}}(\text{triac})$$

[Apri Calcolatrice](#)

$$\text{ex } 196.12^\circ\text{C} = 102.4^\circ\text{C} + 0.66\text{W} \cdot 0.142\text{k}\Omega$$



## Variabili utilizzate

- $A_{v(fet)}$  FET guadagno di tensione (Volt)
- $BV_{soa(igbt)}$  Tensione di guasto SOA IGBT (Volt)
- $C_{(g-c)(igbt)}$  Capacità da gate a collettore (IGBT) (Farad)
- $C_{(g-e)(igbt)}$  Capacità da gate a emettitore (IGBT) (Farad)
- $C_{gd(fet)}$  Capacità di drenaggio del gate FET (Farad)
- $C_{gs(fet)}$  FET di capacità della sorgente di gate (Farad)
- $C_{in(igbt)}$  Capacità di ingresso (IGBT) (Farad)
- $G_m(fet)$  FET a transconduttanza diretta (Millisiemens)
- $G_o(fet)$  FET conduttanza del canale (Millisiemens)
- $I_{avg(triac)}$  TRIAC corrente di carico medio (Millampere)
- $I_d(fet)$  Assorbimento della corrente FET (Millampere)
- $I_d(igbt)$  Corrente di drenaggio (IGBT) (Millampere)
- $I_{dss(fet)}$  Corrente di drenaggio polarizzata zero (Millampere)
- $i_{e(igbt)}$  Corrente elettronica (IGBT) (Millampere)
- $i_{e(igbt)}$  Corrente dell'emettitore (IGBT) (Millampere)
- $i_f(igbt)$  Corrente diretta (IGBT) (Millampere)
- $I_h(igbt)$  Corrente nel buco (IGBT) (Millampere)
- $I_{peak(triac)}$  TRIAC della corrente di picco (Millampere)
- $I_{rms(triac)}$  RMS Corrente TRIAC (Millampere)
- $N_p(igbt)$  Carica positiva netta (IGBT) (Coulomb)
- $P_{(triac)}$  Potenza di dissipazione TRIAC (Watt)
- $P_{max(igbt)}$  Massima dissipazione di potenza (IGBT) (Watt)
- $P_{max(triac)}$  TRIAC massima dissipazione di potenza (Milliwatt)
- $R_{ce(igbt)}$  Resistenza del collettore e dell'emettitore (IGBT) (Kilohm)
- $R_{ch(igbt)}$  Resistenza canale N (IGBT) (Kilohm)
- $R_d(fet)$  FET di resistenza al drenaggio (Kilohm)
- $R_d(igbt)$  Resistenza alla deriva (IGBT) (Kilohm)
- $R_s(fet)$  FET di resistenza della sorgente (Kilohm)
- $R_s(igbt)$  Conducibilità Resistenza IGBT (Kilohm)
- $R_s(triac)$  Resistenza Conduttività TRIAC (Kilohm)
- $R_{th(j-a)(triac)}$  Giunzione al TRIAC della Resistenza Termica Ambiente (Kilohm)



- $R_{th(jc)}$  Resistenza termica (IGBT) (Kilohm)
- $T_a$ (triac) TRIAC temperatura ambiente (Centigrado)
- $T_c$ (igbt) IGBT temperatura custodia (Centigrado)
- $T_{dl}$ (igbt) Tempo di ritardo (IGBT) (Secondo)
- $t_{f1}$ (igbt) Tempo di caduta iniziale (IGBT) (Secondo)
- $t_{f2}$ (igbt) Tempo di caduta finale (IGBT) (Secondo)
- $T_{gd-off(fet)}$  Capacità di drenaggio del gate Tempo di disattivazione FET (Secondo)
- $T_{gs-off(fet)}$  Capacità sorgente gate Tempo di disattivazione FET (Secondo)
- $T_{jmax(igbt)}$  Giunzione operativa massima (IGBT) (Centigrado)
- $T_{jmax(triac)}$  Giunzione massima operativa TRIAC (Centigrado)
- $T_{off(igbt)}$  Orario di spegnimento (IGBT) (Secondo)
- $V_{B-E(pnp)}$ (igbt) Tensione base emettitore PNP IGBT (Volt)
- $V_{ce}$ (igbt) Tensione totale di collettore ed emettitore (IGBT) (Volt)
- $V_{c-e(sat)}$ (igbt) Tensione di saturazione dal collettore all'emettitore (IGBT) (Volt)
- $V_{cut-off(fet)}$  FET di tensione di interruzione (Volt)
- $V_{dd(fet)}$  Tensione di alimentazione al FET di drenaggio (Volt)
- $V_{ds(fet)}$  FET di tensione della sorgente di drenaggio (Volt)
- $V_{ds-off(fet)}$  FET di tensione della sorgente di drenaggio Pinch OFF (Volt)
- $V_{gd(fet)}$  FET di tensione da gate a drain (Volt)
- $V_{j1}$ (igbt) Tensione Pn Giunzione 1 (IGBT) (Volt)
- $V_{knee}$ (triac) TRIAC di tensione al ginocchio (Volt)
- $V_{off(fet)}$  Tensione di spegnimento (Volt)
- $V_{ON}$ (igbt) Caduta di tensione sullo stadio (IGBT) (Volt)
- $\theta_{j-c}$ (igbt) Giunzione all'angolo del case (IGBT) (Grado)
- $\Psi_0$ (fet) FET potenziale di superficie (Volt)



## Costanti, Funzioni, Misure utilizzate

- **Costante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288

Costante di Archimede

- **Funzione:** sqrt, sqrt(Number)

Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato.

- **Misurazione:** Tempo in Secondo (s)

Tempo Conversione unità 

- **Misurazione:** Corrente elettrica in Millampere (mA)

Corrente elettrica Conversione unità 

- **Misurazione:** Temperatura in Centigrado (°C)

Temperatura Conversione unità 

- **Misurazione:** Carica elettrica in Coulomb (C)

Carica elettrica Conversione unità 

- **Misurazione:** Potenza in Watt (W), Milliwatt (mW)

Potenza Conversione unità 

- **Misurazione:** Angolo in Grado (°)

Angolo Conversione unità 

- **Misurazione:** Capacità in Farad (F)

Capacità Conversione unità 

- **Misurazione:** Resistenza elettrica in Kilohm (kΩ)

Resistenza elettrica Conversione unità 

- **Misurazione:** Conduttanza elettrica in Millisiemens (mS)

Conduttanza elettrica Conversione unità 

- **Misurazione:** Potenziale elettrico in Volt (V)

Potenziale elettrico Conversione unità 



## Controlla altri elenchi di formule

- Dispositivi transistor avanzati Formule 
- Dispositivi transistor di base Formule 
- Chopper Formule 
- Raddrizzatori controllati Formule 
- Raddrizzatori non controllati Formule 
- Azionamenti CC Formule 

Sentiti libero di CONDIVIDERE questo documento con i tuoi amici!

### PDF Disponibile in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/15/2024 | 5:04:18 AM UTC

[Si prega di lasciare il tuo feedback qui...](#)

